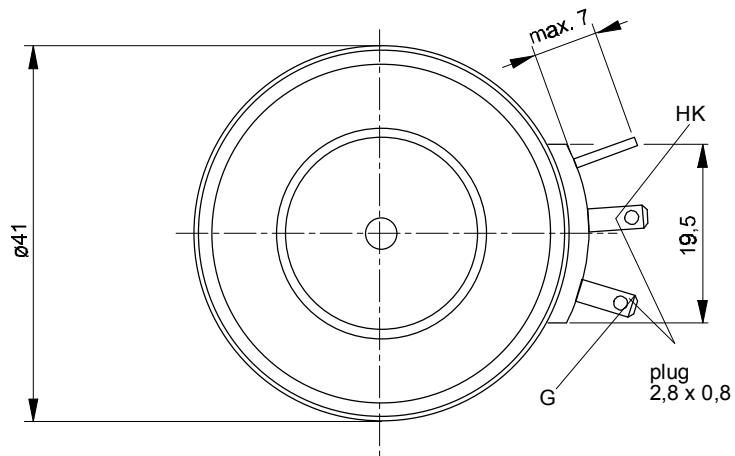
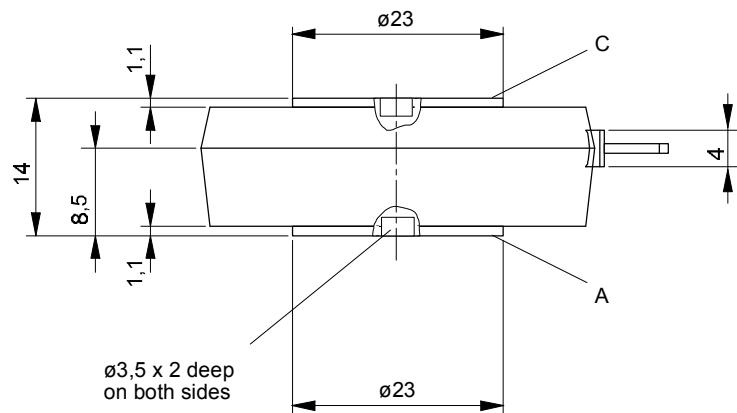




European Power-
Semiconductor and
Electronics Company

Marketing Information T 568 N



T 568 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties			
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>			
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$		V_{DRM}, V_{RRM}	200 400 600 V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung	non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$		$V_{DSM} = V_{DRM}$	200 400 600 V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$		$V_{RSM} = V_{RRM}$	250 450 650 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current			I_{TRMSM}	900 A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_c = 85^\circ\text{C}$		I_{TAVM}	568 A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		I_{TSM}	7800 A
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$		6700 A
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$			304000 A ² s
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$DIN IEC 747-6, f = 50 \text{ Hz}, v_L = 10 \text{ V}, i_{GM} = 0.6 \text{ A}, di_G/dt = 0.6 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{cr}$		225000 A ² s
		$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 0.67 V_{DRM}$			200 A/ μ s
		5.Kennbuchstabe/5th letter F			
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>			
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, i_1 = 2000 \text{ A}$	V_T		max. 1,76 V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}$	$V_{T(TO)}$		0,8 V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\max}$	r_T		0,44 mΩ
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}		max. 150 mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}		max. 1,4 V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}		max. 5 mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}		max. 2,5 mA
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	I_H		max. 0,2 mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	I_L		max. 200 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$i_{GD} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$	I_D, I_R		max. 600 A
Zündverzug	gate controlled delay time	$DIN IEC 747-6 t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 0,6 \text{ A}, di_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}		max. 3,0 μs
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = t_{vj\max}, i_{TM} = i_{TAVM}, V_{RM} = 100 \text{ V}, V_{DM} = 0,67 \text{ V}_{DRM}, dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}, di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_q		typ. 200 μs
		4.Kennbuchstabe/4th letter O			
Thermische Eigenschaften		Thermal properties			
Innerer Wärmewiderstand, beidseitig	thermal resistance, junction to case for two-sided cooling	$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$		R_{thJC}	max. 0,068 °C/W
für anodenseitige Kühlung	for anode-sided cooling	DC			max. 0,065 °C/W
für kathodenseitige Kühlung	for cathode-sided cooling	$\Theta = 180^\circ \text{ el, sin}$	$R_{thJC(A)}$		max. 0,113 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	DC		$R_{thJC(K)}$	max. 0,110 °C/W
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature				max. 0,159 °C/W
Betriebstemperatur	operating temperature				max. 0,156 °C/W
Lagertemperatur	storage temperature				max. 0,030 °C/W
		$t_{vj\max}$			140 °C
		t_{cop}			-40...+140 °C
		t_{stg}			-40...+140 °C
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties			
Si-Elemente mit Druckkontakt, Amplifying	Si-pellet with pressure contact,amplifying				
Gate	gate			F	4...8 kN
Anpreßkraft	clamping force				
Gewicht	weight			G	typ. 70 g
Kriechstrecke	creepage distance				17 mm
Feuchtekategorie	humidity classification	$DIN 40040$			C
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$			50 m/s ²
Maßbild, anliegend	outline, attached				

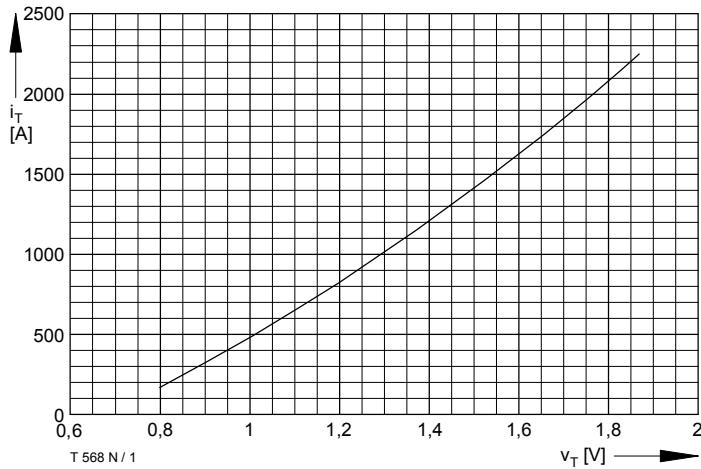


Bild / Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic
 $i_T = f(v_T)$, $t_{vj} = 140^\circ\text{C}$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{\text{thn}} [\text{°C/W}]$	0,00832	0,0151	0,0181	0,0207	0,002856
$\tau_n [\text{s}]$	0,000826	0,0166	0,0808	0,359	1,957

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5	6
$R_{\text{thn}} [\text{°C/W}]$	0,00961	0,00543	0,0209	0,0142	0,0271	0,0328
$\tau_n [\text{s}]$	0,00104	0,0133	0,0364	0,23	1,52	10,5

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{\text{thn}} [\text{°C/W}]$	0,0098	0,0186	0,0157	0,0617	0,0502
$\tau_n [\text{s}]$	0,00106	0,0227	0,0994	2,04	10,2

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{\text{thJC}} = \sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} R_{\text{thn}} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$